

Сокращения параметров полупроводниковых приборов

В настоящее время практически каждому радиолюбителю и профессионалу приходится работать с различными справочными данными по подбору полупроводниковых приборов. При это возникают определенные трудности, когда необходимо разобраться с тем, что означает то или иное сокращение. Для того, чтобы восполнить этот пробел приводится таблица общепринятых сокращений при обозначении параметров полупроводниковых приборов.

Таблица 1

BW	Bandwidth	Полоса пропускания
C _{CB}	Collector to Base Capacitance	Емкость коллектор-база
CG	Conversion Gain	Усиление преобразования
CM	Cross Modulation или Common Mode	Кросс-модуляция или обычный режим
BV _{CER}	Collector-Emitter Breakdown Voltage	Пробивное напряжение коллектор-эмиттер
BV _{CEO}	Collector-Emitter Breakdown Voltage	Пробивное напряжение коллектор-эмиттер
BV _{EBO}	Collector-Base Breakdown Voltage	Пробивное напряжение коллектор-база
C _{OB}	Output Capacitance	Выходная емкость
C _{RE}	Common Emitter Reverse Transfer Capacitance	Обратная проходная емкость транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером
Duty	Duty Cycle	Рабочий цикл; максимальная нагрузка
f _T	Unity Gain Bandwidth Product	Частота единичного усиления
f _{IN}	Input Frequency	Входная частота
f _{MAX}	Maximum Frequency of Oscillation	Максимальная частота генерации
f _{STB}	Oscillator Frequency Stability	Стабильность частоты генератора
f _{OP}	Operating frequency	Рабочая частота
G _A	Associated Gain	Связанное усиление
G _L	Linear Gain	Линейное усиление
G _M	Transconductance	Проводимость
G _P	Power Gain	Коэффициент усиления по мощности

(Продолжение следует)